



Микросхемы К198НТ1А, К198НТ1Б
К198НТ2А, К198НТ2Б
К198НТ3А, К198НТ3Б
К198НТ4А, К198НТ4Б



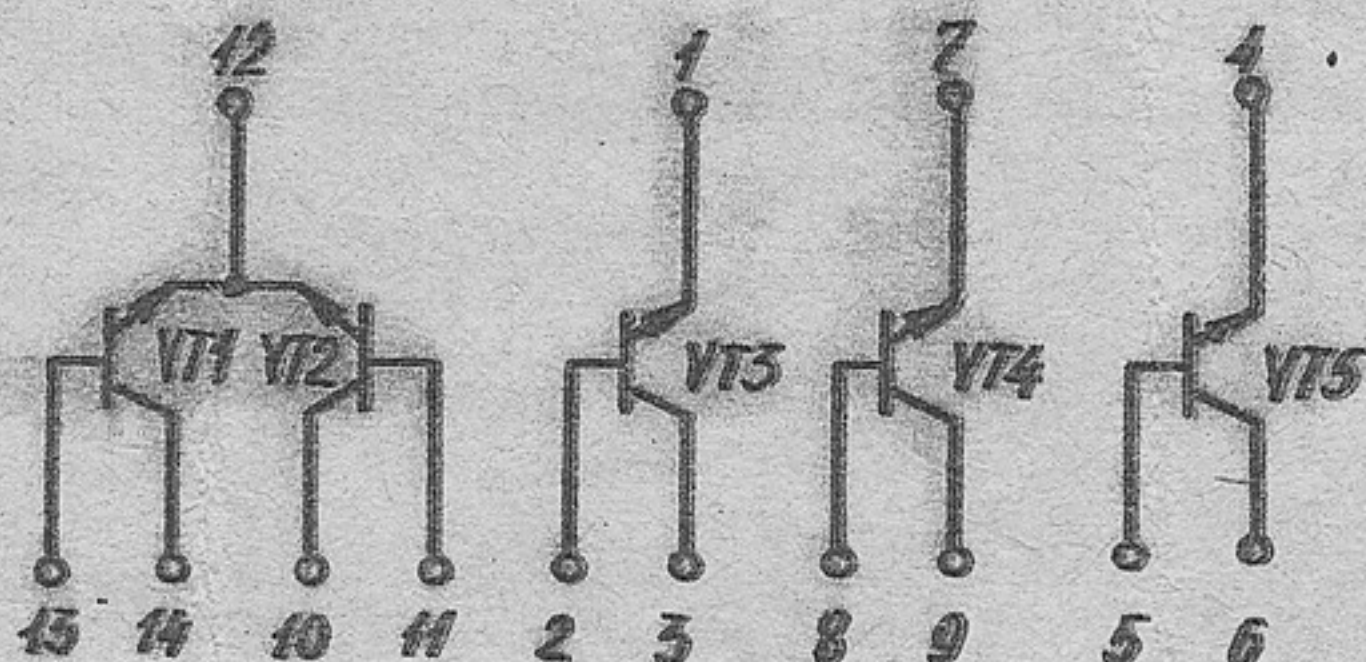
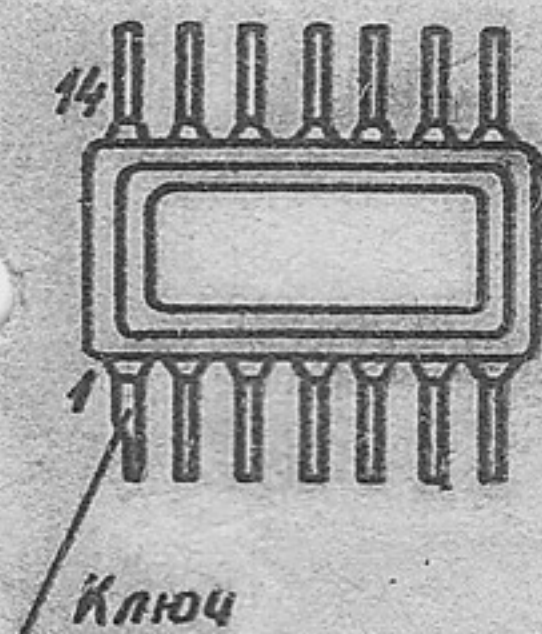
Э Т И К Е Т К А

Кремниевые интегральные микросхемы

"Матрица транзисторов п-р-п типа"

Схема расположения выводов

Схема электрическая принципиальная
для К198НТ1



для К198НТ2 - без транзистора VT4
для К198НТ3 - без транзистора VT1
для К198НТ4 - без транзисторов VT2, VT5

Основные электрические параметры
(при температуре окружающей среды $25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Наименование параметра	Корпус	
	К198НТ1А К198НТ2А К198НТ3А К198НТ4А	К198НТ1Б К198НТ2Б К198НТ3Б К198НТ4Б
Статический коэффициент передачи тока транзистора в схеме с общим эмиттером, h_{213} . (при $U_{КБ}=3В$, $I_3=0,5\text{ мА}$)	20-125	60-250
Обратный ток коллектора транзистора, $I_{КБ0}$. (при $U_{КБ}=6В$), мкА, не более	0,04	
Напряжение насыщения база-эмиттер, $U_{Бэнас}$. (при $I_К=3\text{ мА}$, $I_Б=0,5\text{ мА}$), В, не более	1,0	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, $U_{Кэнас}$. (при $I_К=3\text{ мА}$, $I_Б=0,5\text{ мА}$), В, не более	0,7	
Разброс статических коэффициентов передачи тока транзисторов дифференциальной пары, Δh_{213} . (при $U_{КБ}=3В$, $I_3=0,5\text{ мА}$), %, не более $\frac{h_{213max} - h_{213min}}{h_{213max} + h_{213min}} \cdot 100$	Б	
Разброс напряжений между базой и эмиттером транзисторов дифференциальной пары, $\Delta U_{Бэ}$. (при $\sum I_3=0,5\text{ мА}$, $U_{КБ}=3В$), мВ, не более	4	

Допустимые режимы эксплуатации

(в диапазоне рабочих температур от минус 45 до + 85°C)

Наименование параметра	Норма
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, $U_{КБ\ max}$, В	20
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, $U_{КЭК\ max}$, (при $R_E \leq 400\ \Omega$), В	15
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, $U_{ЭБ\ max}$, В	-5
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, $I_{К\ max}$, мА	10
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при температуре до +35°C	
- одним транзистором, $P_{К\ max}$, мВт	20
- матрицей, P_{max} , мВт	80
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при температуре до +85°C	
- одним транзистором, $P_{К\ max}$, мВт	15
- матрицей, P_{max} , мВт	60
Максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора в режиме насыщения, $I_{К\ нас\ max}$, мА	30

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Золото

мг в одной микросхеме

Технические условия 0.348.004 ТУ

19,4737Мг-Зл999,9

0,8730Мг-ср999,9

ОТК

